PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-294077

(43)Date of publication of application: 04.11.1998

(51)Int.CI.

H01J 40/00 G01J 1/02

H01J 37/073

(21)Application number: 09-103003

(71)Applicant:

JEOL LTD

(22)Date of filing:

21.04.1997

(72)Inventor:

NISHIKAWA OSAMU

IWATSUKI MASASHI

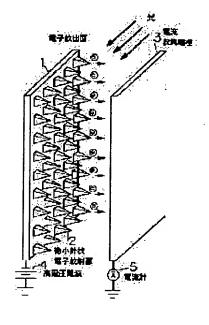
AOKI SUSUMU

(54) FIELD EMISSION TYPE LIGHT-ELECTRIC CURRENT CONVERTER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a light-electric current converter which can respond at high speed, make the current amount to be converted higher, and lower noise much more.

SOLUTION: It is so designed that a plurality of small needle shaped electron emitting sources 2 arranged densely are approached to a current collecting electrode 3 while being faced to each other, voltage is applied to a gap between each electron emitting source 2 and the current collecting electrode 3 so as to allow high electric fields to be generated at the tip end parts of the electron emitting sources 2, and light is made to irradiate the tip end parts of the electron emitting sources 2, so that current in response to the intensity of irradiation light is taken out of the current collecting electrode 3.



(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-294077

(43)公開日 平成10年(1998)11月4日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

FΙ

H01J 40/00

G01J 1/02

H01J 37/073

Α

H01J 40/00 G01J 1/02

H01J 37/073

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全4頁)

(21)出願番号

特願平9-103003

(22)出願日

平成9年(1997)4月21日

(71)出願人 000004271

日本電子株式会社

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

(72)発明者 西川 治

石川県金沢市窪7-364 西尾ビル608

(72)発明者 岩槻正志

東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号日本電

子株式会社内

(72) 発明者 青木 進

東京都昭島市武蔵野三丁目1番2号日本電

子株式会社内

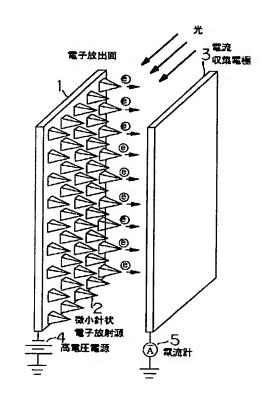
(74)代理人 弁理士 蛭川 昌信 (外7名)

(54) 【発明の名称】電界放射型光一電流変換器

(57)【要約】

【課題】 高速応答が可能で、かつ変換電流量が大きく、低ノイズ化を図ることを可能にする。

【解決手段】 密集配列した微小針状電子放射源と、電流収集電極とを近接して対向配置し、微小針状電子放射源と電流収集電極間に電圧を印加して微小針状電子放射源先端部に高電界を発生させ、該微小針状電子放射源先端部に光を照射してその表面より電子を放射させ、照射光強度に応じた電流を電流収集電極より取り出すようにしたことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 密集配列した微小針状電子放射源と、電流収集電極とを近接して対向配置し、微小針状電子放射源と電流収集電極間に電圧を印加して微小針状電子放射源先端部に高電界を発生させ、該微小針状電子放射源先端部に光を照射してその表面より電子を放射させ、照射光強度に応じた電流を電流収集電極より取り出すようにした電界放射型光一電流変換器。

【請求項2】 請求項1記載の変換器において、微小針 状電子放射源の先端部に引出し電極を設けたことを特徴 10 とする電界放射型光一電流変換器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は微小針状電子放射源の鋭い針先に高電界を発生させ、これに光を照射して電子を放出させ、光を電流に変換する電界放射型光一電流変換器に関するものである。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】光一電流変換器として最も広く用いられているものはフォトマ 20 ルチプライヤであり、また、Charge Coupling Device (CCD) と呼ばれる電荷結合素子である。フォトマルチプライヤの利点は極めて微弱な光にも応答し、増幅率が大きいことであり、難点は応答速度がマイクロセカンド程度と遅く、変換電流量がマイクロアンペアと小さく、さらに光の強度と電流量との相関関係にバラツキがあり、暗電流とノイズが高いことである。また、CCDは直接光を電流量に変換するのではなく、光を一度電荷に変換し、その後読み取り段階で電流に変換できる。従って、光の強度と電流量の相関関係 30 は極めて高いという利点があるが、変換過程が 2 段階であるため応答速度が遅く、その機構も複雑である。

【0003】本発明は上記課題を解決するためのもで、 高速応答が可能で、かつ変換電流量が大きく、低ノイズ 化を図ることができる電界放射型光一電流変換器を提供 することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の電界放射型光一電流変換器は、密集配列した微小針状電子放射源と、電流収集電極とを近接して対向配置し、微小針状電子放射 40源と電流収集電極間に電圧を印加して微小針状電子放射源先端部に高電界を発生させ、該微小針状電子放射源先端部に光を照射してその表面より電子を放射させ、照射光強度に応じた電流を電流収集電極より取り出すようにしたことを特徴とする。

[0005]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。電界放射とは鋭い針先に高電界を発生させ、それにより針先の表面内に閉じ込められている電子に対するポテンシャル障壁を縮小させ、電子を表面より 50

放出させる現象をいう。金属の針では放射電流量は針先の電界強度により大きく増減するが、半導体、特に絶縁性に近い半導体では針先に光を照射すると、光電導率が瞬間的に増大し、電流量が大きく増大する。この原理を本発明では光一電流変換器に応用する。

【0006】図1は本発明の電界放射型光一電流変換器の基本構造の説明図である。図1において、電子放出面を形成する導電性基板1には絶縁性または半絶縁性の微小針状電子放射源2が密集配列され、これに向き合って電流収集電極3が配置される。微小針状電子放射源2は通常の電界放射顕微鏡のような単一の針として構成しても良いが、変換器に用いる場合は、変換効率をあげるために、微細な針を密集形成させる。各微小針の大きさは変換効率、変換応答速度により様々であるが、高さ数μm~数百μmが望ましい。そして、各針の間隔も針の高さに応じて数μm~数百μmと広くなる。針先は鋭ければ鋭い方が望ましく、先端の曲率半径が0.1μm以下になるまで研磨すると低電圧(1000V以下)で電界放射電流量が得られるようになる。

【0007】電流収集電極3は微小針状電子放射源2の 先端より数μm離れた位置に配置される。なお、導電性 基板1と電流収集電極3の間には高電圧電源4が接続され、電流収集電極3を流れる電流は電流計5で測定される。

【0008】次に動作を説明すると、まず高電圧電源4により電子放出面の微小針状電子放射源2と電流収集電極3との距離や、微小針状電子放射源2の曲率半径に応じて数百V~数KV程度の電圧を印加し、電界放射電流が流れる状態にする。その後、光を微小針状電子放射源に照射する。すると、光の強度に対応して放射電流が変化して電流収集電極3を通して流れる電流が変化し、光を電流に変換することができる。

【0009】図2は本発明の光一電流変換器の他の例を示す図である。

【0010】この例は、図1に示した変換器に対してさ らに変換感度を向上させるために微小針状電子放射源2 に対向して引出し電極10を設け、さらに電流収集電極 3の前方にマイクロチャンネルプレート12を配置した ものである。引出し電極10は微小針状電子放射源2の 先端を囲むように円錐状の孔が形成された突起状の微小 電極からなり、微小針状電子放射源2と引出し電極10 とのアライメントに圧電素子11を使用しており、圧電 素子11に電圧を印加することにより、電流収集電極3 に最も電流が流れるように位置合わせを行う。この引出 し電極10は白金等の金属の薄板を微小なポンチにより 機械的に孔を開けることにより作成する方法やマイクロ リソグラフィ技術を応用する方法、あるいは電鋳法等に より作成する。なお、マイクロチャンネルプレート12 と電流収集電極3との間は高電圧電源13を挿入する。 このマイクロチャンネルプレート12により微小電流が 増倍されるので、電流量は増大するが、構造が複雑とな 導性、 るので、このマイクロチャンネルプレートに代えて電流 る。特 収集電極3と電流計5との間に増幅器を挿入するように 間であ

しても良い。 【0011】また、電流収集電極3は透明度の高いサファイアかガラスで作成し、ネサ膜(酸化スズ等の膜)のような電導性の薄膜で覆う。この場合ネサ膜の光透過特性により変換器が応答する光の波長範囲が変わる。従って、ネサ膜をフィルターとすると、特定波長に応答する

変換器を構成することができる。

【0012】図3は光一電流変換器の変換感度を向上させるようにした他の例を示す図である。この例は、導電性基板1の上に絶縁体を介して各微小針状電子放射源2の先端を取り囲むような孔が開けられた引出し電極板21を設けたもので、絶縁体20は微小針状電子放射源2が貫通する孔が開けられている。微小針状電子放射源2と引出し電極板21との間には所定の引出し電圧が印加される。このような構成とすることにより、電子放出に必要な電圧を下げることが可能である。

【0013】なお、上記各例において、密集配列微小針 20 状電子放射源、引出し電極、電流収集電極の作成は微細 加工が求められるので、近年進展が目ざましい真空マイ クロエレクトロニクスやマイクロリソグラフィーの技術 を応用して作製する。

【0014】なお、電子放射源については、金属は光電導の効果がなく、絶縁性または半絶縁性の材料を用いる。シリコンは微細加工技術が進んでいるので、最良の材料と考えられるが、電子放射面が不安定なので、望ましくない。放射面が安定で電子放出効果が優れているものはダイヤモンドである。しかし、ダイヤモンドの微細 30な針を作製することは困難である。そこで、図4に示すようにシリコンまたは金属で密集配列微細針状放射源2を作製し、その表面にダイヤモンド、または半絶縁性か絶縁性で光電導性の下地金属の炭化、酸化、窒化物の薄膜2aを形成し、安定な電子源とすることが可能である。

【0015】この場合、微細針状電子放射源先端の放射 領域の炭化膜、窒化膜、酸化膜、ダイヤモンド膜等の電 導性、厚さ、組成、構造により光一電流変換特性が変わる。特に注目したいのは応答する光の波長範囲と応答時間である。

【0016】図5は光照射時間と応答する放射電流の波形を示したもので、光照射時間幅はナノ秒からフェムト秒であり、この光パルスに応答する変換器では絶縁性薄膜材料の光一電流変換の即応性と膜の厚みが均一で、数ナノメートルであることが求められる。

【0017】光パルスと放射電流との時間差は光一電流 10 変換器および計測器内の時間遅れであり、光照射量が弱 く、照射時間幅が狭いと放射電流が減衰し、検出されな くなる。また、光の波長にも依存する。従って、特定の 波長パルス幅のみ応答する光一電流変換器を作ることも 可能である。

[0018]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、絶縁性または半絶縁性の薄膜を表面に形成した微小針状電子放射源の鋭い針先に高電界を発生させ、この針先に光を照射することにより光の強度に応じた電流を対向する電流収集電極から取り出すことができ、光一電極変換器に応用することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 電界放射型光ー電流変換器の基本構造の説明 図である。

【図2】 光一電流変換器の他の例を示す図である。

【図3】 光一電流変換器の変換感度を向上させるようにした他の例を示す図である。

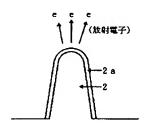
【図4】 微細針状放射源を作製方法を説明する図である。

【図5】 光照射時間と応答する放射電流の波形を示す 図である。

【符号の説明】

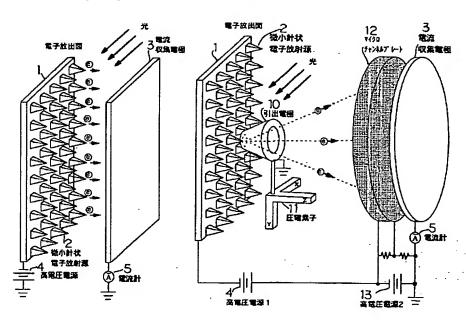
1…導電性基板、2…微小針状電子放射源、3…電流収集電極、4…高電圧電源、5…電流計、10…引出し電極、11…圧電素子、12…マイクロチャンネルプレート、13…高電圧電源、20…絶縁体、21…引出し電極板。

[図4]



【図1】

【図2】



[図3]

【図5】

